

半 导 体 学 报

第 8 卷 第 4 期 1987 年 7 月

目 录

用离子自注入改善 SOS 单晶膜质量的研究	
.....范仁永 郁元桓 褚一鸣 殷士端 林兰英 (337)	
横向电压型压力传感器灵敏度的几何效应	鲍敏杭 齐薇佳 王言 (345)
Si(331)-6×2 表面相及其氧吸附特性	邢益荣 (351)
亚稳半导体 (GaAs) _{1-x} (Ge ₂) _x 的能带结构	徐至中 (356)
微波功率晶体管管内匹配网络	徐天东 (362)
MOS 器件三维数值模拟	陈大同 吴启明 王泽毅 李志坚 (371)
两微米外延 N 阱 CMOS 工艺的研究	马槐楠 徐葭生 (378)
P 埋层 GaAs MESFET 研究	史常忻 李晓明 忻尚衡 陈益新 (385)
硅禁带宽度的温度关系	易明铤 (391)
二元化合物总原子溅射率和刻蚀速率的经验公式	陈国樑 (395)
条形半导体激光器中电过程和光波导过程的精确理论	郭长志 丁凡 (402)
流体静压力下窄禁带 Hg _{1-x} Cd _x Te 电学性质的研究	刘冉 沈学础 (410)

研 究 简 报

Si 中注入 Zn 的辐射损伤	
.....殷士端 张敬平 顾 诤 许振嘉 刘家瑞 章其初 李大万 (418)	
半导体材料表面光洁度对光吸收表观值的影响	王桂芬 马根源 张光寅 (423)
键轨道参数的直接计算	钟学富 (426)
锗硅单晶扩散系数理论探讨及各晶向扩砷实验	陈忠景 陈为民 林政伟 (429)
a-Si _{1-x} C _x :H/pn ⁻ in 结构的蓝白色电致发光	张仿清 张亚非 陈光华 (433)
近红外全离子注入平面结构锗雪崩光电探测器的研制	丁国庆 阚希文 (437)
GaAs IC 逻辑门静态特性的分析	史常忻 余 兴 (443)
高阻化合物电阻率的测量方法	祁增芳 (445)
第二届全国多值逻辑学术讨论会在重庆大学召开	黄开源 (449)